

2SD892, 2SD892A

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形ダーリントン/Si NPN

Epitaxial Planar Darlington

低周波増幅用/AF Amplifier

■ 特徴/Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} が高く設計されているので、モータドライブ、プリンタ用ハンマドライブなどに適している： $h_{FE}=2000\sim 20000$ /High h_{FE} design, suitable for motor driver and hammer driver: $h_{FE}=2000\sim 20000$.
- ドライバにはシャント抵抗を省いている。/Driver having no shant resistor.

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SD892	30	V
	2SD892A	60	
コレクタ・エミッタ電圧	2SD892	25	V
	2SD892A	50	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	0.75	A
コレクタ電流	I_C	0.5	A
コレクタ損失	P_C	400*	mW
接合部温度	T_J	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~+150	°C

*ポッティングタイプは $P_C=250$ mW/Potting type : $P_C=250$ mW

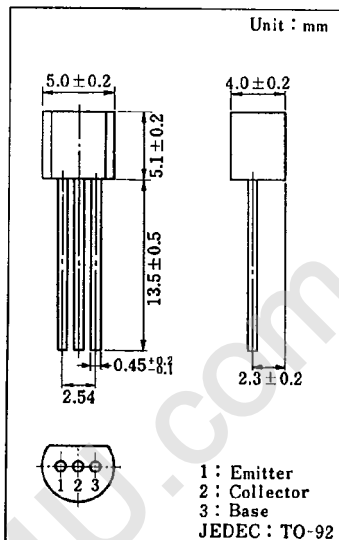
■ 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=25$ V, $I_E=0$			100	nA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=4$ V, $I_C=0$			100	nA
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C=100$ μ A, $I_E=0$	30			V
			60			
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CFO}	$I_C=1$ mA, $I_B=0$	25			V
			50			
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=100$ μ A, $I_C=0$	5			V
直流電流増幅率	h_{FE}^{*1}	$V_{CE}=10$ V, $I_C=500$ mA ^{*2}	2000		20000	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500$ mA, $I_B=0.5$ mA ^{*2}			2.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=500$ mA, $I_B=0.5$ mA ^{*2}			3	V

^{*2}パルス測定/Pulse Test

^{*1} h_{FE} ランク分類/ h_{FE} Classifications

Class	P	Q	R
h_{FE}	2000~5000	4000~10000	8000~20000



内部接続図/Connection Diagram

